

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也・諸岡 哲

日時 10月25日(水) 14:00~17:20

26日(木) 9:30~14:30

会場 東北大学未来情報産業研究館5F 大会議室(仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-10. 地下鉄東西線; 青葉山駅から徒歩1分. <http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/map.html> TEL [022] 795-4833 黒田理人)

議題 プロセス科学と新プロセス技術

25日

1. [招待講演] 段差ゼロの平坦化技術: CMP 前の PMD 体積調整 ○掛川智康・二瀬卓也(サンディスク)
2. Experimental Investigation of Localized Stress Induced Leakage Current Distribution and its Decrease by Atomically Flattening Process Hyeonwoo Park・○Rihito Kuroda・Tetsuya Goto・Tomoyuki Suwa・Akinobu Teramoto・Daiki Kimoto・Shigetoshi Sugawa (Tohoku Univ.)
3. 化学酸化膜を用いた Ar/H₂ 熱処理による Si 表面原子レベル平坦化と Hf 系 MONOS 構造への応用
○工藤聡也・大見俊一郎(東工大)
4. 塗布型拡散剤を用いた nm 対応コンフォーマルドーピング技術
○木下哲郎・真下峻一・大橋卓矢・澤田佳宏・木下洋平・藤村悟史(東京応化)
5. [招待講演] HfO₂ をゲート絶縁膜に用いたペンタセン OFET のデバイス特性に関する検討
○前田康貴・劉 野原・廣木瑞葉・大見俊一郎(東工大)

◎平成28年度SDM研究専門委員会若手優秀発表賞表彰式

26日午前

1. [招待講演] ビックデータの活用によるメモリ製造革新 赤堀浩史(東芝メモリ)
2. 紫外吸光とチャージアンプ回路を用いた高感度・小型リアルタイムガス濃度計
○石井秀和(東北大)・永瀬正明・池田信一(フジキン)・志波良信・白井泰雪・黒田理人・須川成利(東北大)
3. ZrO₂ シード層が Hf₂Zr_{1-x}O₂ 薄膜の強誘電性へ及ぼす効果
○女屋 崇(明大/物質・材料研究機構)・生田目俊秀(物質・材料研究機構/JST)・澤本直美(明大)・大井暁彦・池田直樹・知京豊裕(物質・材料研究機構)・小椋厚志(明大)

26日午後

4. [依頼講演] 28nm スプリットゲート MONOS 型フラッシュメモリを用いたエラーフリー読み出し方法を有する PUF 技術
○下井貴裕・斉藤朋也・長瀬寛和・伊豆名雅之・神田明彦・伊藤 孝・河野隆司(ルネサス エレクトロニクス)
5. スクライブ上モニタパタンのシート抵抗測定によるイメージセンサの空乏化電位管理について
○後藤洋太郎(ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング)・山口 直・松浦正純(ルネサス エレクトロニクス)・飯塚康治(ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング)
6. 高精度アレイテスト回路計測技術を用いたソースフォロアトランジスタの動作条件変化によるランダムテレグラフノイズの挙動解析 ○市野真也・間脇武蔵・寺本章伸・黒田理人・若嶋駿一・須川成利(東北大)

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月9日(木), 10日(金) 機械振興会館[締切済] テーマ: プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

12月22日(金) 京大[10月13日(金)] テーマ: Si, Si を含む材料の作製, プロセス技術, デバイス, 及びディスプレイ関連技術

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp